2N3713 2N3715 2N3714 2N3716

SILICON NPN TRANSISTORS



TO-3 CASE



www.centralsemi.com

R2 (18-June 2013)

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N3713, 2N3714, 2N3715, and 2N3716 are silicon NPN power transistors manufactured by the epitaxial-base process, mounted in a hermetically sealed metal package designed for medium speed switching and amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

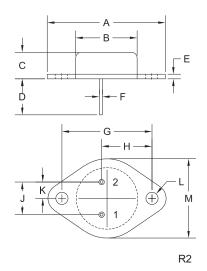
MAXIMUM RATINGS: (T _C =25°C) Collector-Base Voltage		SYMBOL V _{CBO}	2N3713 2N3715 80	2N3714 2N3716 100	UNITS V	
Collector-Emitter Voltage		VCEO	60	80	V	
Emitter-Base Voltage		VEBO	7	·.0	V	
Continuous Collector Current		I _C	10		Α	
Continuous Base Current		ΙΒ	4.0		Α	
Power Dissipation		P_{D}	150		W	
Operating and Storage Junction Temperature		T _J , T _{stg} -6		+200	°C	
Thermal Resistance		Θ _{JC} 1.17		.17	°C/W	
ELECTRICA SYMBOL	AL CHARACTERISTICS: (T _C =25°C unle TEST CONDITIONS V _{CE} =Rated V _{CBO} , V _{BE} =1.5V	ess otherwise MIN	noted) TYP	MAX 1.0	UNITS mA	
ICEV	V _{CE} =Rated V _{CEO} , V _{BE} =1.5V, T _C =1	150°C		10	mA	
I _{EBO}	V _{EB} =7.0V			5.0	mA	
BV_{CEO}	I _C =200mA (2N3713, 2N3715)	60			V	
BV_{CEO}	I _C =200mA (2N3714, 2N3716)	80			V	
V _{CE} (SAT)	I _C =5.0A, I _B =0.5A (2N3713, 2N3714)			1.0	V	
V _{CE} (SAT)	I _C =5.0A, I _B =0.5A (2N3715, 2N3716)			0.8	V	
V _{BE} (SAT)	I _C =5.0A, I _B =0.5A (2N3713, 2N3714)			2.0	V	
V _{BE} (SAT)	I _C =5.0A, I _B =0.5A (2N3715, 2N3716)			1.5	V	
V _{BE} (ON)	V_{CE} =2.0V, I_{C} =3.0A			1.5	V	
hFE	V _{CE} =2.0V, I _C =1.0A (2N3713, 2N371			120		
hFE	V _{CE} =2.0V, I _C =1.0A (2N3715, 2N371	,		150		
h_{FE}	V _{CE} =2.0V, I _C =3.0A (2N3713, 2N371					
hFE	V _{CE} =2.0V, I _C =3.0A (2N3715, 2N371					
f _T	V_{CE} =10V, I_{C} =0.5A, f=1.0MHz	4.0			MHz	
t _r	I _C =5.0A, I _{B1} =I _{B2} =0.5A		0.4		μs	
t_S	I _C =5.0A, I _{B1} =I _{B2} =0.5A		0.3		μs	
t _f	I _C =5.0A, I _{B1} =I _{B2} =0.5A		0.4		μs	

2N3713 2N3715 2N3714 2N3716

SILICON **NPN TRANSISTORS**



TO-3 CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS								
	INCHES		MILLIMETERS					
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX				
Α	1.516	1.573	38.50	39.96				
B (DIA)	0.748	0.875	19.00	22.23				
С	0.250	0.450	6.35	11.43				
D	0.433	0.516	11.00	13.10				
Е	0.054	0.065	1.38	1.65				
F	0.035	0.045	0.90	1.15				
G	1,177	1.197	29.90	30.40				
Н	0.650	0.681	16.50	17.30				
J	0.420	0.440	10.67	11.18				
K	0.205	0.225	5.21	5.72				
L (DIA)	0.151	0.172	3.84	4.36				
М	0.984	1.050	25.00	26.67				

TO-3 (REV: R2)

LEAD CODE:

- 1) Base

2) Emitter Case) Collector

MARKING:

FULL PART NUMBER



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331